

物理電子システム創造専攻 平成17年度 博士構想(中間)発表会プログラム

ver. 20051215

会場：G 2－5 0 1 会議室 2005年12月26日

(構想発表：発表15分, 質疑30分 / 旧電シ中間発表：発表15分, 質疑10分)

開始時間	研究室			名前	題名
10:00	岩井・杉井研	D2後	中間	ンジン アン	A Study on Mobility of High-k Gate Dielectric MISFET
10:25	岩井・杉井研	D2	中間	佐々木雄一郎	プラズマドーピングに関する研究開発
10:50	休憩				
11:00	徳光研	D1	構想	日野 史郎	絶縁膜/SiCの界面制御とデバイス応用に関する研究
11:45	石原研	D1	構想	井端 雅一	カーボンナノチューブを用いた強誘電体ゲートFETの研究
12:30					